

# 2SD772, 2SD772A, 2SD772B

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

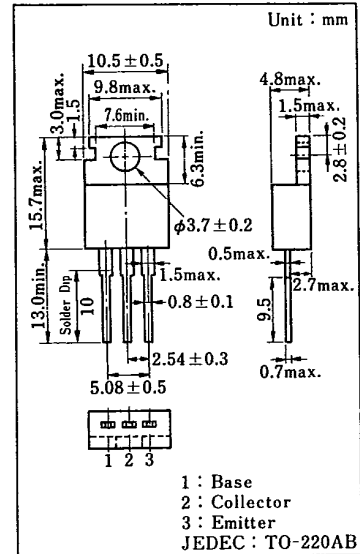
低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

## ■ 特徴 / Features

- コレクタ・ベース電圧  $V_{CBO}$  が高い。 / High  $V_{CBO}$
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

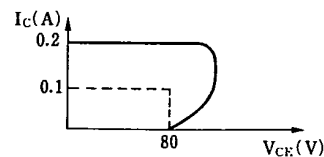
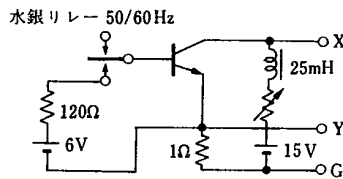
## ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Rating ( $T = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD772	150	V
	2SD772A	200	
	2SD772B	250	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD772	150	V
	2SD772A	200	
	2SD772B	250	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	80	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	40	A
コレクタ電流	$I_C$	5	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )	$P_c$	40	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

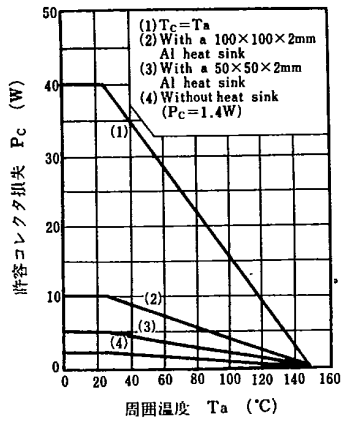


## ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

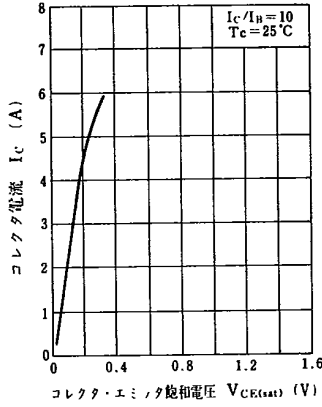
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	2SD772	$V_{CB} = 150\text{ V}, I_E = 0$			1	mA
	2SD772A	$V_{CB} = 200\text{ V}, I_E = 0$			1	
	2SD772B	$V_{CB} = 150\text{ V}, I_E = 0$			1	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}^*$	$I_C = 0.2\text{ A}, L = 25\text{ mH}$	80			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E = 1\text{ mA}, I_C = 0$	6			V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 5\text{ A}$	14			
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 5\text{ A}$			1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 5\text{ A}, I_B = 1\text{ A}$			1.6	V
下降時間	$t_f$	$I_C = 5\text{ A}, I_{B1} = 0.8\text{ A}, -V_{EB} = 5\text{ V}$			1	$\mu\text{s}$
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 0.5\text{ A}$		40		MHz

\*  $V_{CEO(sus)}$  試験回路 /  $V_{CEO(sus)}$  Test Circuit

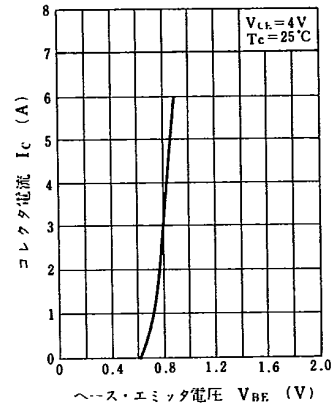
$P_C - T_a$



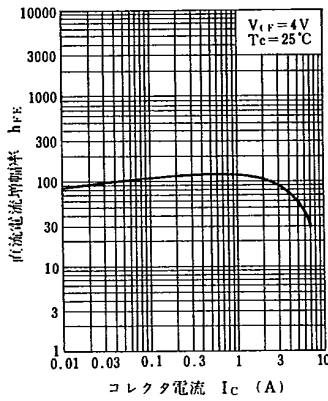
$I_C - V_{CE(sat)}$



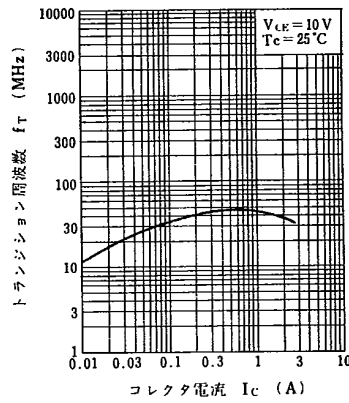
$I_C - V_{BE}$



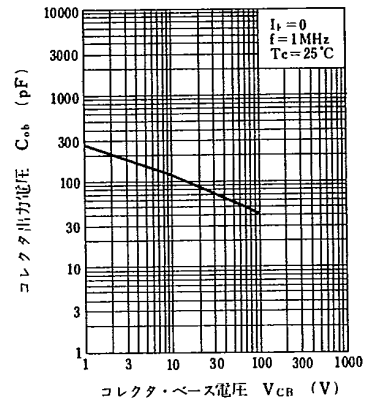
$h_{FE} - I_C$



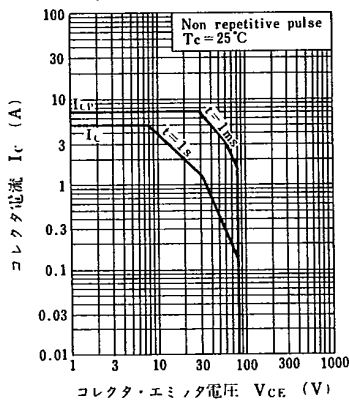
$f_T - I_C$



$C_{ob} - V_{CB}$



安全動作領域 ASO



安全動作領域 ASO

